

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務 — 我們的發展戰略」。

### [編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]的中位數)，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用、佣金及估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們預計[編纂][編纂]將約為[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途，概約金額如下：

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於在珠海新總部建設新生產基地，該基地將取代我們現有的生產設施，並作為我們的辦公場所。根據弗若斯特沙利文的資料，全球等離子處理設備市場規模預期將由2025年的人民幣3,479億元增長至2030年的人民幣5,283億元，複合年增長率為8.7%。為滿足下游客戶不斷增長的需求並利用有利的行業趨勢，我們將提高產能，並將新生產基地用於製造用於PCB及半導體製造、以及用於其他應用領域的等離子處理設備。我們亦計劃購買先進的高精度生產設備，以不斷提高我們生產及裝配工藝的精度及效率。
- 約[編纂]%或[編纂]萬港元將用於投資前瞻技術的研發。這包括對以下研發項目的投資：

	項目	應用
1	PECVD設備開發.....	PECVD設備能夠在低溫條件下沉積多種薄膜，對絕緣層與鈍化層等應用至關重要，其主要用於沉積半導體器件鈍化層、光伏抗反射塗層以及柔性顯示器封裝層。我們的研究聚焦於大面積均勻性控制、等離子體穩定性及加強低溫沉積密度。
2	金屬刻蝕技術.....	金屬刻蝕技術專用於精密蝕刻各類金屬及金屬化合物，對半導體製造中的互連結構與電極形成至關重要，其主要用於形成互連層導電線(如鋁或銅)。我們的研發主要聚焦於精確去除特定區域的金屬膜，同時保護底層結構及側壁，避免短路或開路。

## 未來計劃及[編纂]

項目	應用
3 多晶硅刻蝕技術.....	多晶硅刻蝕對形成晶體管柵極與電容電極至關重要，其用於定義晶體管的核心結構柵極。我們研究聚焦的主要挑戰是多晶矽刻蝕所需的極高精度及尺寸控制。

具體而言，我們計劃(i)通過在我們的新總部建設先進的研發設施以及升級我們的研發及測試設備來增強我們的研發能力，(ii)通過招聘人才及實施系統培訓計劃擴大我們的研發團隊及加強我們的創新能力，及(iii)採購用於研發及中試生產活動的原材料及耗材。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於設立海外辦事處。我們將主要尋求通過部署銷售及售後服務團隊來擴大我們的全球影響力，旨在擴大我們與海外當地客戶的接觸，並優化我們的產品定製以提高客戶滿意度及鞏固我們的市場地位。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於一般公司及營運資金用途。

倘[編纂]定價高於或低於估計[編纂]的中位數或[編纂]獲行使，則上述[編纂]分配將按比例調整。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]的上限)，且假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用、佣金及估計開支後，我們預計[編纂][編纂]將約為[編纂]百萬港元。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]的下限)，且假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用、佣金及估計開支後，我們預計[編纂][編纂]將約為[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)，我們將收取的[編纂]將約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外[編纂]用於上述用途。

倘[編纂][編纂]未即時用於上述用途及在適用法律及法規允許的情況下，我們擬將[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構的短期計息賬戶。倘上述建議[編纂]有任何變動，我們將於適時作出公告。